## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

# Цель работы

Исследование биполярных и полевых транзисторов.

## Учебные задания и методические указания к их выполнению

## Биполярный транзистор

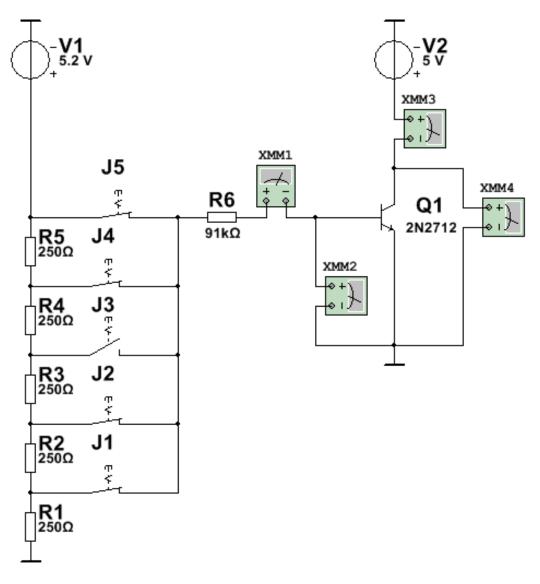


Рисунок 5

#### Назначение элементов схемы

- делитель напряжения  $R_1 R_5$ , ключи  $J_1 J_5$  и резистор  $R_6$  задают пять значений тока базы ( $I_5$ );
- мультиметр XMM1 измеряет ток базы (I<sub>Б</sub>);
- мультиметр XMM2 измеряет напряжение база эмиттер ( $U_{E9}$ );
- мультиметр ХММЗ измеряет ток коллектора биполярного транзистора;
- напряжение коллектор-эмиттер ( $U_{K\! \ni}$ ) устанавливается источником  $V_2$  и фиксируется мультиметром XMM4.

## Задание 1 Построение семейства выходных ВАХ

Задать напряжение источника  $V_1$   $E=5+\sqrt{(N)}$  (в вольтах), где N — номер по списку.

В нечетных вариантах использовать транзистор с n-p-n структурой имеющий маркировку 2N2712.

В четных вариантах использовать транзистор с n-p-n структурой имеющий маркировку 2N1711.

Снять и построить семейство выходных ВАХ биполярного транзистора в схеме ОЭ при ступенчатом изменении входного тока базы ( $I_{\rm B}$ ). Ступенчатое изменение осуществляется путем замыкания одного ключа, последовательно от первого до пятого.

$$I_k = f(U_{\kappa_9}) npu I_E = const$$

Таблица 7

U <sub>кэ</sub> , В	0.3	1	3	5	7	10
I <sub>к1</sub> (при I <sub>Б1</sub> ), мА						
I <sub>к2</sub> (при I <sub>Б2</sub> ), мА						
I <sub>к3</sub> (при I <sub>Б3</sub> ), мА						
I <sub>к4</sub> (при I <sub>Б4</sub> ), мА						
I <sub>к5</sub> (при I <sub>Б5</sub> ), мА						

Мультиметры XMM1 и XMM3 необходимо включить в режим измерения постоянного тока, а мультиметры XMM2 и XMM4 в режим измерения постоянного напряжения.

Установить значение источника  $V_2$  равное 5 В.

Включая поочередно ключи  $J_1-J_5$  зафиксировать значения токов базы ( $I_{\rm b1}-I_{\rm b5}$ ).

Выставить напряжение  $U_{K9}$  = 0.3 В и последовательно изменяя ток базы от  $I_{\text{Б1}}-I_{\text{Б5}}$  перенести значения токов коллектора  $I_{\text{K1}}$ -  $I_{\text{K5}}$  в таблицу 7.

Повторить измерение для других значений  $U_{K\ni}$  (см. таблицу 7).

# Задание 2 Расчет коэффициента усиления и выходного сопротивления

$$\beta = \frac{\Delta I_{\kappa}}{\Delta I_{E}}$$
 при  $U_{\kappa 9} = 5B$  И  $r_{\text{вых}} = \frac{\Delta U_{K9}}{\Delta I_{K}}$  при  $I_{6} = I_{63}$ 

Для вычисления  $r_{\text{вых}}$  необходимо взять ближайшие показания  $U_{\text{к} \ni}$  3B или 7B.

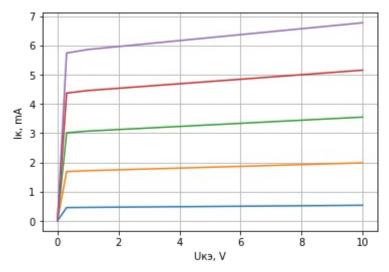


Рисунок 6 Семейство выходных ВАХ биполярного транзистора

## Задание З Построение входной ВАХ

Снять и построить входную BAX биполярного транзистора при  $U_{K9}$  = 5B.

$$I_{\text{Б}} = f(U_{\text{БЭ}})$$
 при  $U_{\text{KЭ}} = 5 \text{ B}$ .

Таблица 8

$I_{\rm B}$	$I_{51}$	I <sub>62</sub>	I <sub>Б3</sub>	I <sub>64</sub>	I <sub>65</sub>
<b>І</b> <sub>Б</sub> , мкА					
U <sub>БЭ</sub> , В					

#### Задание 4 Расчет входного сопротивления

По таблице 8 рассчитать входное дифференциальное сопротивление ( $r_{\mbox{\tiny BX}}$ ) по формуле:

$$r_{\rm ex} = \frac{\Delta U_{\rm E3}}{\Delta I_{\rm E}} npu I_{\rm E} = I_{\rm E3}$$

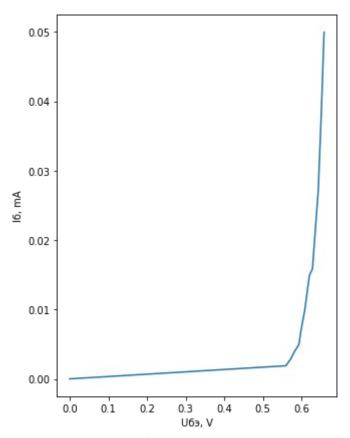
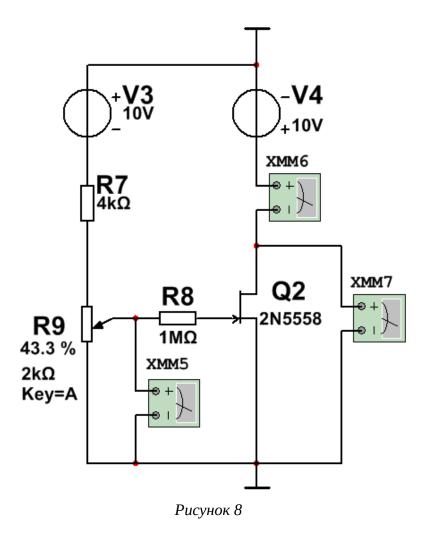


Рисунок 7: ВАХ биполярного транзистора

Для вычисления  $r_{\scriptscriptstyle BX}$  необходимо взять ближайшие показания  $I_{\scriptscriptstyle E4}$  или  $I_{\scriptscriptstyle E2}$ .

#### Полевой транзистор с р-п затвором



#### Назначение элементов схемы

- мультиметр XMM6 измеряет ток стока (I<sub>C</sub>);
- мультиметры XMM5 и XMM7 показывают напряжение  $U_{\text{3и}}$  и  $U_{\text{Cu}}$ ;
- потенциометр  $R_9$  задает напряжение на затворе относительно истока;
- источник постоянного напряжения  $V_4$  задает напряжение  $U_{\text{CM}}$ .

## Задание 5 Построение стоко-затворной характеристики

Задать напряжение источника  $V_3$   $E=9+\sqrt{({\it N})}~$  (в вольтах), где N — номер по списку.

В нечетных вариантах использовать транзистор имеющий маркировку 2N5558.

В четных вариантах использовать транзистор имеющий маркировку 2N5397.

Снять и построить стоко-затворную характеристику полевого транзистора.

$$I_C = f(U_{3U})$$
 при  $U_{CU} = 5$  В.

Таблица 9

U <sub>зи</sub> , В	0				U <sub>OTC</sub> =
I <sub>C</sub> , mA	I <sub>C.HAC</sub> =				$I_{\rm C} = 0$

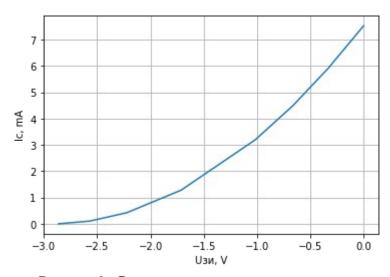


Рисунок 9: Стоко-затворная характеристика полевого транзистора

Мультиметр XMM6 включить в режим измерения постоянного тока, а мультиметры XMM5 и XMM7 в режим постоянного напряжения.

При помощи потенциометра  $R_9$  устаноить напряжение  $U_{3\text{M}}=0$  (максимально близким к нулю) и зафиксировать значение  $I_{\text{C.HAC}}$ .

При помощи потенциометра  $R_9$  добиться показания  $I_C$  близкое к нулю и зафиксировать значение напряжения отсечки ( $U_{OTC}$ ).

Разбить напряжение  $U_{3\text{и}}$  от  $U_{\text{ОТС}}$  до  $U_{3\text{и}}$  = 0 на 5 – 6 точек и заполнить таблицу 9.

#### Задание 6 Расчет крутизны

Рассчитать крутизну в крайних точках таблицы ( $S_{\text{мин}}$  при минимальном токе стока и  $S_{\text{макс}}$  при максимальном).

$$S = \frac{\Delta I_C}{\Delta U_{3U}} \left( \frac{MA}{B} \right)$$

## Задание 7 Построение стоковой ВАХ

$$U_{3 \text{И}} = 0 \text{ И} \quad U_{3 \text{И}} = \frac{U_{omc}}{2}$$
 ,

 $I_C = f(U_{CM})$  при  $U_{3M} = const.$ 

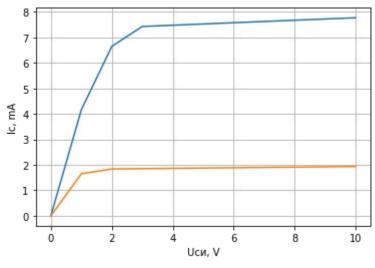


Рисунок 10: Стоковая ВАХ

Таблица 10

<b>U</b> <sub>СИ</sub> , <b>В</b>	1	2	3	4	6	8	10
$I_{C.U3H}=0$ , $MA$							
$I_{C.U3H} = U_{OTC}/2$ , MA							

#### Содержание отчёта

- 1. Наименование и цель работы.
- 2. Электрические расчётные схемы и схемы цепи, собранные в Multisim.
- 3. Расчётные формулы.
- 4. Графики ВАХ, стоко-затворной характеристики.
- 5. Таблицы с расчётными и экспериментальными данными.
- 6. Выводы по работе.